

Перв. примен.		Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание			
			Конденсаторы								
		C1	10мкФ X5R 10% 10В 0805, GRM21BR61 Электролитический				1				
		C2	100 мкФ ЕСАР Электролитический				1				
		C3	10пФ NPO 50В 5% 0805, Керамический				1				
Справочный №		C4	1500мкФ, ЕСАР 10В, 105°С, 20%				1				
		C5	2.2пФ NPO 50В, 5%, 0805 Керамический				1				
		C6	ЕСАР AXIAL (K50-29), 470 мкФ, 63В Электролитический				1				
		C7	2.2мкФ X7R 25В 0805 Керамический				1				
		C8	0.1мкФ X7R 10% 1кВ 2220 Керамический				1				
		C9	5600пФ X7R 50В 10% 0805 GRM40X7R Керамический				1				
		C10	K78-99 45 мкФ, 250 В, 5% Керамический				1				
		C11	0.1 мкФ X7R 10% 250В Керамический				1				
		C12	0.33мкФ X7R 10% 25В 0805 Керамический				1				
		C13	8200пФ X7R 50В 10% 0805 Керамический				1				
		C14	ЕСАР AXIAL (K50-29), 470 мкФ, 63В Электролитический				1				
		C15	150пФ NPO 50В 5% 0805 Керамический				1				
Подпись и дата											
			Диодный мост								
		D1, D2	GBJ2510-F, Диодный мост 25А 1000В				2				
Инв. № дубл.			Микросхемы								
		DA1	LD111 “STMICROELECTRONICS”				1				
		DA2	TNY265 “All POWERINT”				1				
Взам. инв. №		DD1	EPS8266 “Espressif Systems”				1				
		DD2	XY-LPWM “Shenzhen Alisi Electronic Technology”				1				
Подпись и дата											
							ГУИР.565211.001 ЭЗ				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.		Разраб.	Насевич				Модуль преобразователя напряжения  Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов	
		Пров.	Мадвейко					У	1	3	
		Нач. отд.						БГУИР гр.810201			
		Н.контр.									
		Утв.									

Поз. Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
	Микросхемы			
DD3	TCA785HKLA1 “SIEMESNS”	1		
	Реле			
K1, K2	SRD-05VDC-SL-C “SONGLE”	2		
	Резисторы			
R1	0.125Вт 0805 10 кОм, 1%	1		
R2	0.125Вт 0805 3.6 кОм, 1%	1		
R3	0.125Вт 0805 2 кОм, 5%	1		
R4	0.125Вт 0805 1 кОм, 1%	1		
R5	0.062Вт 0402 200 кОм, 1%	1		
R6	0.125Вт 0805 100 кОм, 5%	1		
R7	0.125Вт 0805 15 кОм, 5%	1		
R8	0.125Вт 0805 10 кОм, 5%	1		
R9	0.125Вт 0805 10 Ом, 1%	1		
R10	0.250Вт 0805 10 кОм, 5%	1		
R11	0.250Вт 0805 2 кОм, 5%	1		
R12, R13	0.25Вт 1206 100 кОм, 5%	2		
R14	0.125Вт 0805 1.5 кОм, 5%	1		
R15	0.125Вт 0805 56 кОм, 1%	1		
R16	0.125Вт 0805 91 кОм, 1%	1		
R17	0.125Вт 0805 240 Ом, 1%	1		
R18	0.125Вт 0805 110 кОм, 1%	1		
R19	0.125Вт 0805 56 кОм, 5%	1		
R20-R27	0.125Вт 0805 82 кОм, 1%	6		
R28	3006P-1-501LF, 500 Ом, Резистор подстроечный	1		
			Лист	
ГУИР.565211.001 Э1			2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

